

통신

(Overweight)

NXP 기지국 PA 사업 정리가 만드는 RFHIC 기회

통신 이찬영_02)368-6167_cylee@eugenefn.com

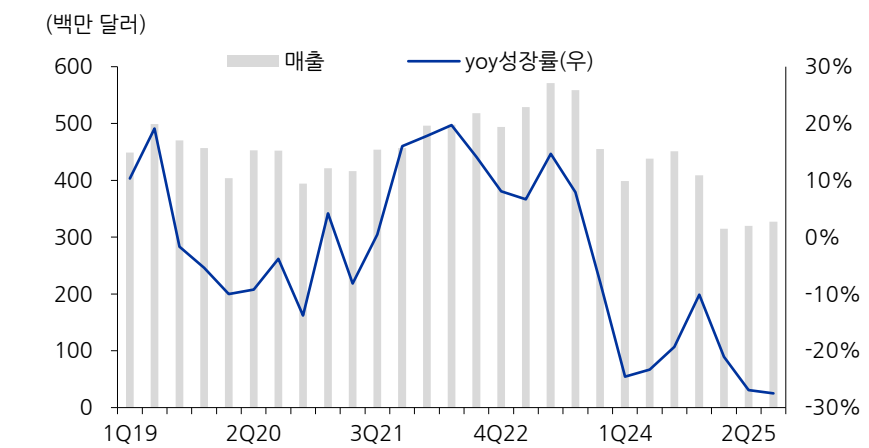
- 최근 글로벌 기지국 RAN 무선장비·부품 밸류체인에서 사업 매각·축소·철수 사례가 지속적으로 발생하고 있음. 5G 인프라 투자 둔화에 따른 수익성 저하와 재무 부담 확대가 공통분모이며, 단기 업황 반등 가시성이 제한적이라는 판단이 의사결정을 앞당긴 것으로 보임
- 12월 10일 Light Reading은 NXP가 기지국 RF 전력증폭기(PA) 사업 및 관련 애리조나 Chandler ECHO Fab(GaN 기반 5G PA 생산)을 **종료하고 2027년 1분기까지 생산 후 사실상 철수할 계획**이라고 보도함. 전방 수요 부진과 회복 불확실성이 직접 원인이지만, 공급사 이탈은 벤더 입장에서 대체 소싱을 요구하는 이벤트이기도 함. 업황 약세를 확인시키는 신호이면서도, 잔존 공급사에게는 물량 재배분 기회를 제공하는 촉매로 해석됨
- RFHIC는 기지국용 GaN 기반 RF 부품(트랜지스터/전력증폭기) 공급 업체로, 통신 부문 주요 고객은 삼성전자임. 삼성은 RF 부품을 멀티벤더 체계로 조달하는 것으로 추정되며, NXP 등 기존 글로벌 공급사가 이탈할 경우 동일 플랫폼 내에서 RFHIC가 대체 물량을 흡수하며 점유율을 높일 여지가 있음
- **다만 기회는 여기에 그치지 않음.** RFHIC가 아직 본격 진입하지 못한 에릭슨·노키아는 삼성 대비 훨씬 큰 RAN 시장점유율을 보유한 글로벌 톱티어 업체이며, 공급사 재편은 이들 벤더향 신규 등록과 양산 확보의 계기가 될 수 있음. 동사는 에릭슨에 샘플을 지속 공급해온 것으로 파악되며, 과거 화웨이 납품 이력을 감안하면 기술 검증 측면의 장벽은 상대적으로 낮다고 판단됨
- 타이밍 측면에서도 우호적임. NXP 철수 시점(1Q27)은 FCC가 추진 중인 미국 Upper C-band(3.98~4.2GHz) 경매 및 후속 투자 사이클과 맞물릴 가능성이 있으며, **해당 대역은 C-Band 상단으로서 고출력 및 고효율 요구가 커 GaN 채택 비중이 확대될 개연성이 큼.** 단순 공급 공백을 넘어 기술 믹스 변화에 따른 TAM 확대라는 구조적 수혜도 기대해볼 만함
- 물론 철수가 시장 위축을 반영한다는 점은 감안해야 함. RFHIC가 점유율을 확대해도 시장 규모가 축소되면 실적 기여도는 제한적일 수 있음. 또한 NXP 이탈에 따른 반사수혜는 웨이퍼 생산 능력을 보유한 스미토모 전기 등에 우선적으로 돌아갈 가능성이 있으며, RFHIC는 웨이퍼 생산 능력이 없어 이 부분에서 불리한 위치에 있음. 그럼에도 동사는 방산 부문이 26~27년 성장을 견인하는 구조에서 통신 의존도가 낮아 다운사이드는 제한적이며, 이번 이벤트로 27년 통신에서도 업사이드 가능성이 생기면서 추정치 상향 여력이 확보됐다는 점은 주목할 만함. 향후 삼성 내 점유율 변화, 웨이퍼 생산제약을 넘어선 수주 확보 가능성, 에릭슨·노키아 양산 진입, Upper C-band 이후 CAPEX 재개 강도를 중심으로 점검이 필요함

도표 1. 글로벌 기업 통신 사업 철수 사례

회사	발표/보도 시기	내용	사유
Wolfspeed	2023-08	RF 사업(주로 GaN-on-SiC RF 사업) MACOM 에 매각 발표	SiC(전력/소재) 중심으로 사업 집중 및 자원 재배치
Casa Systems	2024-04	Chapter 11 파산 신청과 함께 5G Core 및 RAN 사업자산 매각 추진	무선 시장 수요 둔화로 실적 악화, 유동성/재무구조 악화에 따른 사업 매각
CommScope	2024-07	Outdoor Wireless Networks(OWN) 및 DAS 사업을 Amphenol 에 매각	부채 부담 완화 및 포트폴리오 단순화
Kyocera	2025-12	5G 기지국(베이스스테이션) 사업 추진 중단	개발비 급증, 경쟁 심화, 수익성 경로 부재
Huawei	2025-12	유럽 기지국 장비 생산 목적 프랑스 공장(완공됐으나 미가동)의 향후 활용 여부 재검토, 옵션에 매각 포함 가능성 언급	유럽 5G 전개 둔화 및 규제/정책 리스크 확대에 따른 투자자원 우선순위 재조정
NXP	2025-12	기지국 RF 전력(Radio Power) 사업 램프다운 및 Chandler(Arizona) ECHO Fab(GaN) 최종 웨이퍼 1Q27 생산 후 종료(사실상 철수)	5G 인프라 수요 부진·회복 불확실성에 따른 전략적 축소

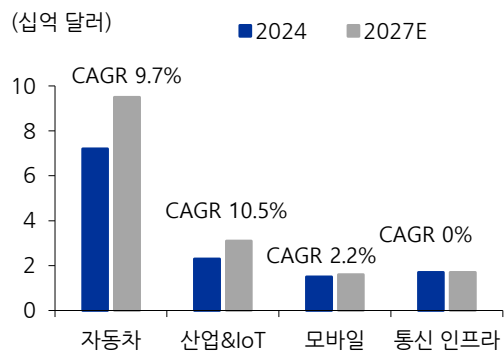
자료: 언론 보도, 유진투자증권

도표 2. NXP 통신 인프라 매출 추이



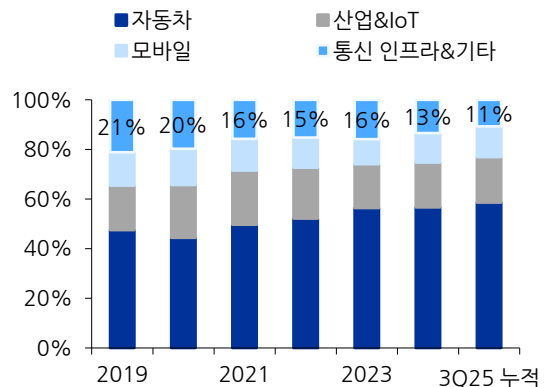
자료: NXP, 유진투자증권

도표 3. NXP 사업부별 성장 가이드스



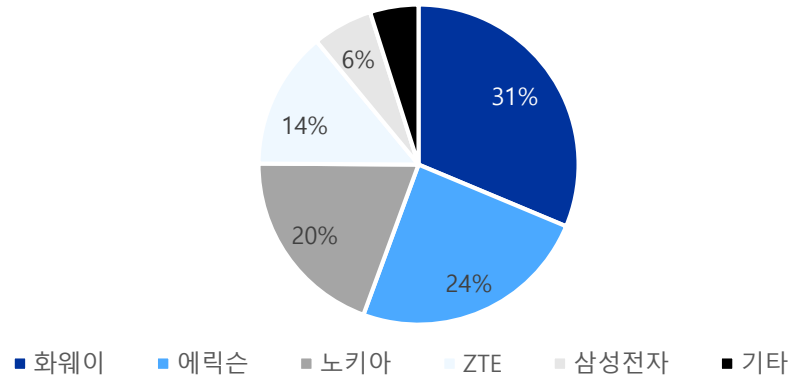
자료: NXP, 유진투자증권

도표 4. NXP 사업부별 매출 비중 추이



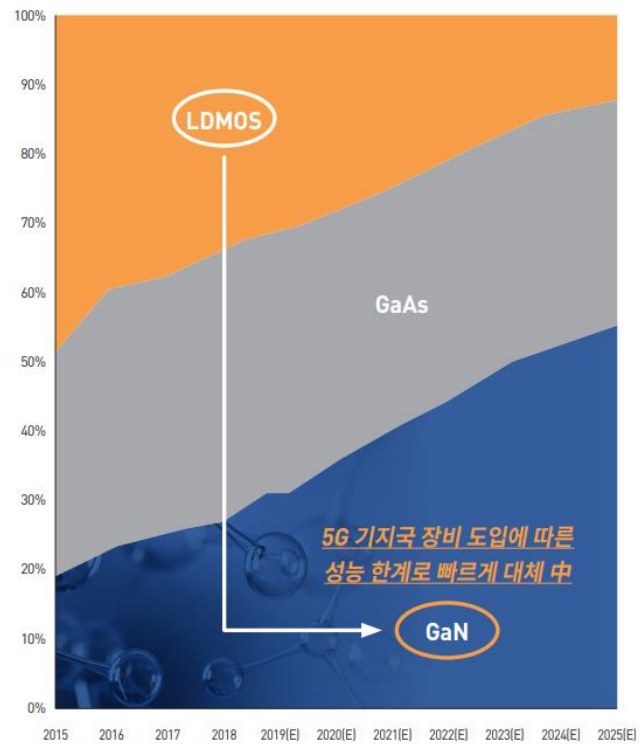
자료: NXP, 유진투자증권

도표 5. 글로벌 기지국 벤더 시장 점유율



자료: Omdia, 유진투자증권
 주: 2023 년 자료

도표 6. GaN 시장 점유율 전망



※ 자료: Yole Development, GaN RF Device Market

자료: RFHIC, Yole Development, GaN RF Device Market

도표 7. 주파수 상향 구간에서의 PA 소자 선택: LDMOS vs GaN

	LDMOS (Si)	GaN	고주파 전환 시 함의
효율-주파수 특성	주파수 상승 시 효율 저하가 상대적으로 빠르게 나타남	주파수 상승에 따른 효율 저하가 상대적으로 완만함	3~4GHz 이상 구간에서 GaN의 효율 우위 확대
전력밀도(동일 출력 대비 소자 면적)	동일 출력 구현 시 소자/회로 면적이 상대적으로 큼	높은 전력밀도로 동일 출력을 더 작은 면적으로 구현	고주파 구간에서 소형화 니즈가 커질수록 GaN 선호도 상승
열/냉각 부담	효율 저하로 발열 및 냉각 부담 증가	높은 전력밀도 및 고온 동작 특성으로 냉각 요구 상대적으로 낮음	고출력고주파 환경에서 열관리 민감도가 높아질수록 GaN 경쟁력 부각

자료: 유진투자증권

도표 8. 통신에서의 LDMOS vs GaN

01 4차 산업 혁명의 기반, 5G와 필수 소재 GaN



※ 자료: 미래부, ITU

자료: RFHIC

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

• STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
• BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	98%
• HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	2%
• REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2025.09.30 기준)